

G12850B5(S)

800W, 50V GaN 射频功率晶体管

Mar 25 2022



Product datasheet.V1.0

概要描述

G12850B5(S)是一款 800W 的内匹配设计的 GaN 射频功率晶体管，专为频率范围在 960MHz 至 1200MHz 的脉冲放大器应用而设计。当其应用于其他频率时，无法保证其性能。建议仅在脉冲条件下使用此设备，且随着脉冲宽度的增加和占空比的升高，其额定功率会有所降低。

典型应用性能

I: 测试条件: Vds = 50V, Idq = 100mA; 信号模式: Pulsed CW, 20us 10%

测试 960-1225MHz 的典型短波脉冲性能，焊接装配

Freq (MHz)	P1dB (dBm)	P1dB (W)	P1dB Eff (%)	P1dB Gain (dB)	P3dB (dBm)	P3dB (W)	P3dB Eff (%)
960	59.23	836.8	54.9	14.71	59.76	945.7	56.0
1000	59.31	853.8	58.0	14.88	60.14	1032.7	61.9
1050	59.2	830.9	60.4	14.89	60.26	1060.8	65.8
1100	58.71	742.2	60.5	14.66	59.95	987.4	65.8
1150	58.59	722.7	61.9	14.52	59.4	871.1	62.9
1200	58.55	716.6	61.7	14.29	59.34	859.9	62.0
1225	58.55	716.2	61.0	14.25	59.32	854.1	60.9

800W, 50V GaN 射频功率晶体管

II: 测试条件: $V_{DS} = 50V$, $I_{DQ} = 100mA$; 信号模式: Pulsed CW, 300us 30%

测试 960-1225MHz 的典型长波脉冲性能, 焊接装配

Freq(MHz)	Pin(dBm)	Pout(dBm)	Pout(W)	IDS(A)	Gain(dB)	Eff(%)
960	46	59.2	831.76	9.6	13.2	51.99
1000	46.2	59.6	912.01	9.64	13.4	56.76
1050	46.7	60.0	1000.00	9.56	13.3	62.76
1100	46.6	59.6	912.01	8.8	13.0	62.18
1150	46.9	59.2	831.76	8.3	12.3	60.13
1200	47.3	59.1	812.83	8.33	11.8	58.55
1225	47	59.07	807.24	8.3	12.1	58.35

产品特点

- 适用于 L 波段航空电子设备的宽带应用;
- 耐热增强型工业标准封装;
- 采用高可靠性金属化工艺;
- 优异的热稳定性以及出色的耐用性;
- 符合有害物质限制 (RoHS) 指令 2002/95/EC 无铅。

加电顺序

打开设备

- 1、将 V_{GS} 加至-5V
- 2、将 V_{DS} 打开至额定工作电压(50V)
- 3、增加 V_{GS} , 直到出现 I_{DS} , 表明晶体管开启
- 4、打开驱动, 输入功率

关闭设备

- 1、先关闭驱动
- 2、将 V_{DS} 降低至-5V, 过程中 I_{DS} 逐渐降低至 0 mA
- 3、将 V_{DS} 降低至 0 V
- 4、关闭 V_{GS}

典型参数说明

表 1. 热特性参数

参数	符号	值	单位
热阻 (管芯封装至法兰) 测试条件: TC= 85°C, Pout=800W@1.1GHz 20us/10%, 50Vdc, Idq=100mA	R _{θJC}	0.2	°C/W

表 2. 极限参数

参数	符号	值	单位
漏极电压	V _{DSS}	+200	Vdc
栅极电压	V _{GS}	-8 to +0	Vdc
工作电压	V _{DD}	0 to 55	Vdc
最大正向栅极电流	I _{gmx}	108	mA
储存温度范围	T _{stg}	-65 to +150	°C
封装工作温度	T _C	+150	°C
工作结温	T _J	+225	°C

注意: 在最高结温下连续运行将影响 MTTF。

表 3. 电学特性参数(T_C=25°, 除非特殊注明)

直流特性					
参数及符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{(BR)DSS} --击穿电压	V _{GS} =-8V、I _{DS} =120mA	---	200	---	V
V _{GS(th)} --开启电压	V _{DS} =10V、I _D =120mA	-4		-2	V
V _{GS(Q)} --栅极静态电压	V _{DS} =50V、I _{DS} =100mA	---	-3.37	---	V

注意: V_{GS(Q)}--栅极静态电压: 数据来源于典型应用测试。

800W, 50V GaN 射频功率晶体管

表 4. 典型应用参数(TC=25°, 除非特殊注明)

参数及符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
Gp--功率增益@P1dB	基于东科芯测试架 (50ohm 系统) V _{DD} = 50Vdc、I _{DQ} = 100mA Freq= 1100MHz 测试信号: Pulsed CW, 20us 20%	---	14	---	dB
Eff--漏极效率@Psat		---	65	---	%
Psat--饱和输出功率		---	59.5	---	dBm
IRL--回波损耗		---	-7	---	dB

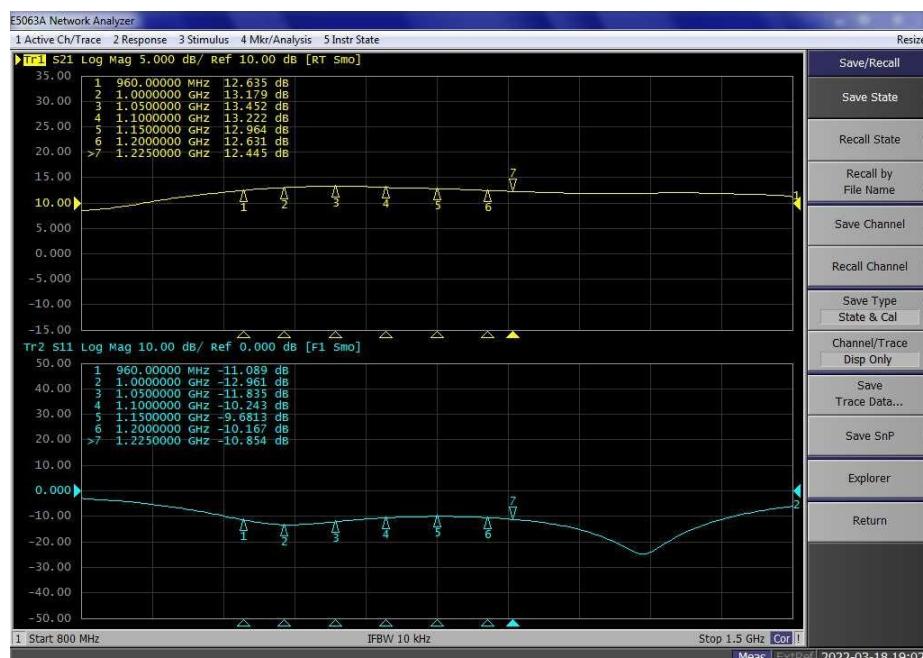
表 5. 坚固性特性参数

特性	测试条件	符号	最小值	典型值	最大值
失配负载能力	V _{DD} =50V、I _{DQ} =100mA、Freq= 1100MHz	VSWR	--	10:1	--

注意: VSWR 10:1 at 800W pulse CW Output Power (测试时无晶体管损坏)。

典型测试曲线与版图

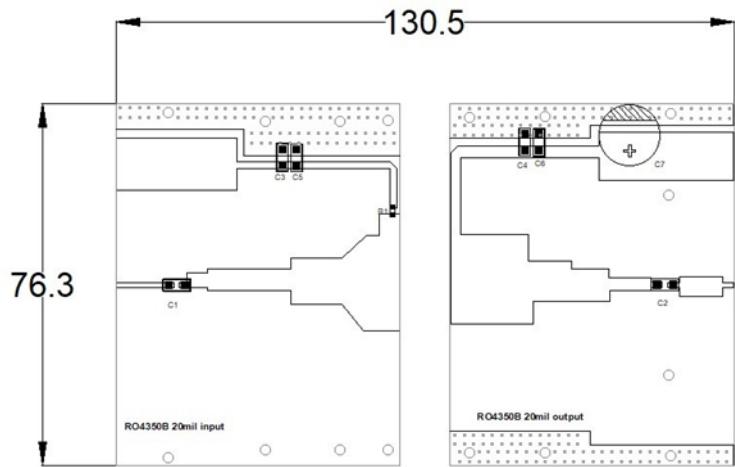
小信号测试性能

 测试条件: V_{DS}=50V, I_{DQ}=500mA, V_{GS}=-3.13V


G12850B5(S)

800W, 50V GaN 射频功率晶体管

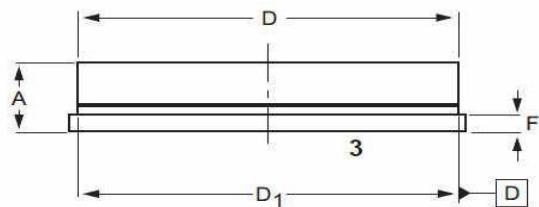
测试版图



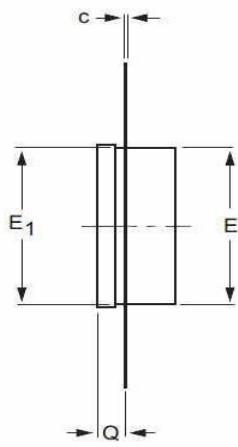
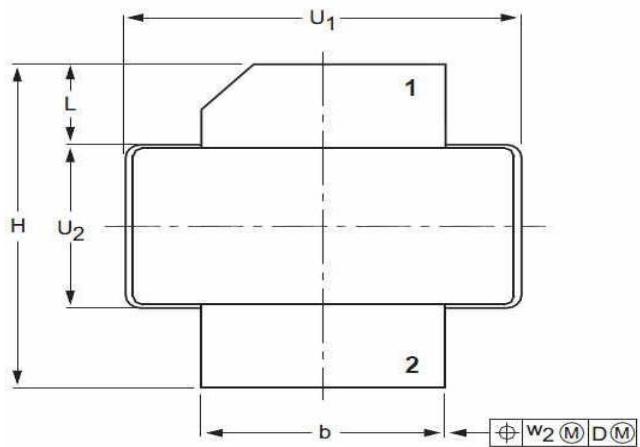
频段 960-1225MHz (20mil Rogers4350)

更多测试数据具体见测试报告。

封装尺寸图


BS-2 封装

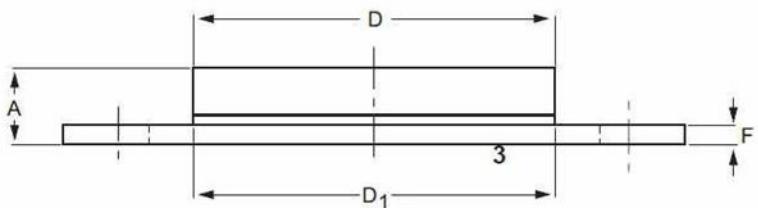
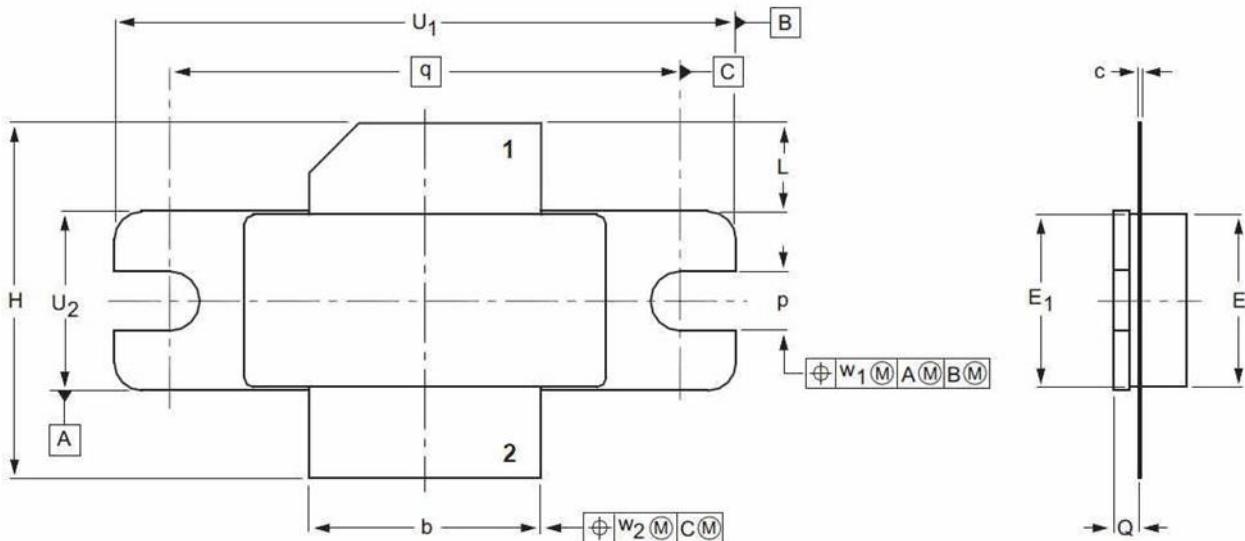
1—Drain、2—Gate、3—Source


 0 5 10 mm
scale

G12850B5(S)

800W, 50V GaN 射频功率晶体管

UNIT	A	b	c	D	D ₁	E	E ₁	F	H	L	Q	U ₁	U ₂	W ₂
mm	4.72	12.83	0.15	20.02	19.96	9.50	9.53	1.14	19.94	5.33	1.70	20.70	9.91	
	3.43	12.57	0.08	19.61	19.66	9.30	9.25	0.89	18.92	4.32	1.45	20.45	9.65	0.25
inches	0.186	0.505	0.006	0.788	0.786	0.374	0.375	0.045	0.785	0.210	0.067	0.815	0.390	
	0.135	0.495	0.003	0.772	0.774	0.366	0.364	0.035	0.745	0.170	0.057	0.805	0.380	0.010


B-2 封装
1—Drain、2—Gate、3—Source

 0 5 10 mm
scale

UNIT	A	b	c	D	D ₁	E	E ₁	F	H	L	p	Q	q	U ₁	U ₂	W ₁	W ₂
mm	4.72	12.83	0.15	20.02	19.96	9.50	9.53	1.14	19.94	5.33	3.38	1.70	27.94	34.16	9.91	0.25	0.51
	3.43	12.57	0.08	19.61	19.66	9.30	9.25	0.89	18.92	4.32	3.12	1.45	33.91	9.65			
inches	0.186	0.505	0.006	0.788	0.786	0.374	0.375	0.045	0.785	0.210	0.133	0.067	1.100	1.345	0.390	0.01	0.02
	0.135	0.495	0.003	0.772	0.774	0.366	0.364	0.035	0.745	0.170	0.123	0.057		1.335	0.380		

800W, 50V GaN 射频功率晶体管

版本修订记录

日期	版本	修订说明	备注
2022-03-25	1.0	发布初版数据手册	

注意事项

- (1) 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。请客户及时到本公司网站下载更新 <http://www.rfwatt.com/>.
- (2) 请注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使 PA 内的功耗不超过封装的容许功耗。更多频段测试数据请参考相应测试报告。